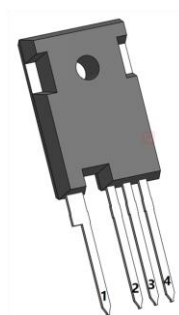


1200V 50mΩ SiC MOSFET

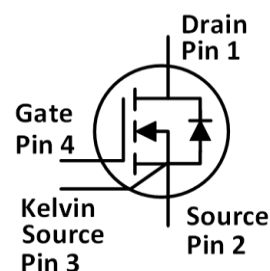
特点

- 高压、低导通电阻
- 高速、寄生电容小
- 高工作结温
- 快速恢复体二极管
- 开尔文连接驱动

封装示意图:



TO247-4



应用

- 光伏逆变器
- UPS 电源
- 电机驱动
- 高压 DC/DC 变换器
- 开关电源

最大额定值 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	典型值	单位	测试条件	备注
V _{DS}	漏源电压	1200	V	V _{GS} =0V, I _D =100μA	
V _{GSmax} (DC)	最大直流栅源电压	-5 to 22	V	静态 (DC)	
V _{GSmax} (Spike)	最大尖峰栅源电压	-10 to 25	V	<1%占空比, 脉冲宽度 <200ns	
V _{GSon}	推荐的开通栅源电压	20±0.5	V		
V _{GSoff}	推荐的关断栅源电压	-3.5 to -2	V		
I _D	最大漏源电流	58	A	V _{GS} =20V, T _c =25°C	图 21
		43	A	V _{GS} =20V, T _c =100°C	
I _{DM}	最大脉冲漏源电流	145	A	根据器件安全工作区确定	图 24
P _{TOT}	最大耗散功率	344	W	T _c =25°C	图 22
T _{stg}	存储温度范围	-55 to 175	°C		
T _J	工作结温范围	-55 to 175	°C		
T _L	焊接温度	260	°C	引线处波峰焊接, 距外壳 1.6 毫米, 持续不超过 10 秒	

热阻特性

符号	参数说明	典型值	单位	备注
R _{θ(J-C)}	结到外壳的热阻	0.436	°C/W	图 23

电学特性 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
I _{DSS}	关断时的漏极漏电流		5	100	μA	V _{DS} =1200V, V _{GS} =0V	
I _{GSS}	栅极漏电流			±100	nA	V _{DS} =0V, V _{GS} = -5~20V	
V _{TH}	阈值电压	1.8	3.2	5	V	V _{GS} =V _{DS} , I _D =6mA	图 8, 9
			2.2			V _{GS} =V _{DS} , I _D =6mA @ T _J =175℃	
R _{ON}	导通电阻		50	65	mΩ	V _{GS} =20V, I _D =20A @T _J =25℃	图 4, 5, 6, 7
			80		mΩ	V _{GS} =20V, I _D =20A @T _J =175℃	
C _{iss}	输入电容		2750		pF	V _{DS} =800V, V _{GS} =0V, f=1MHz, V _{AC} =25mV	图 16
C _{Oss}	输出电容		106		pF		
C _{rss}	反向传输电容		5.2		pF		图 17
E _{Oss}	输出电容存储能量		43		μJ	V _{DS} =800V, I _D =20A, V _{GS} = -5 to 20V	图 18
Q _g	栅极总电荷		120		nC		
Q _{gs}	栅源电荷		25		nC		
Q _{gd}	栅漏电荷		48		nC		
R _g	栅极输入电阻		2.8		Ω	f=1MHz	
E _{ON}	导通能量		455.4		μJ	V _{DS} =800V, I _D =30A, V _{GS} = -2 to 20V, R _{G(ext)} =3.3Ω, L=450μH	图 19, 20
E _{OFF}	关断能量		213.6		μJ		
t _{d(on)}	导通延迟时间		8.9		ns		
t _r	上升时间		28.9				
t _{d(off)}	关断延迟时间		25.6				
t _f	下降时间		17.2				

体二极管特性 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
V_{SD}	正向电压		4.9		V	$I_{SD}=20\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$	图 10, 11, 12
			4.4		V	$I_{SD}=20\text{A}, V_{GS}=0\text{V},$ $T_J=175^{\circ}\text{C}$	
t_{rr}	反向恢复时间		20		ns	$V_{GS}=-2\text{V}/+20\text{V},$ $I_{SD}=30\text{A}, V_R=800\text{V},$ $di/dt=1200\text{A}/\mu\text{s},$ $R_{G(ext)}=20\Omega$ $L=450\mu\text{H}$	
Q_{rr}	反向恢复电荷		143.9		nC		
I_{RRM}	反向恢复峰值电流		13		A		

典型特征曲线

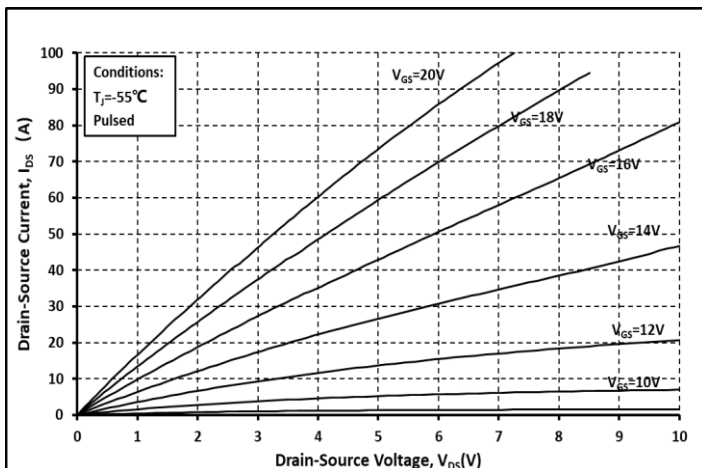


图. 1 输出曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

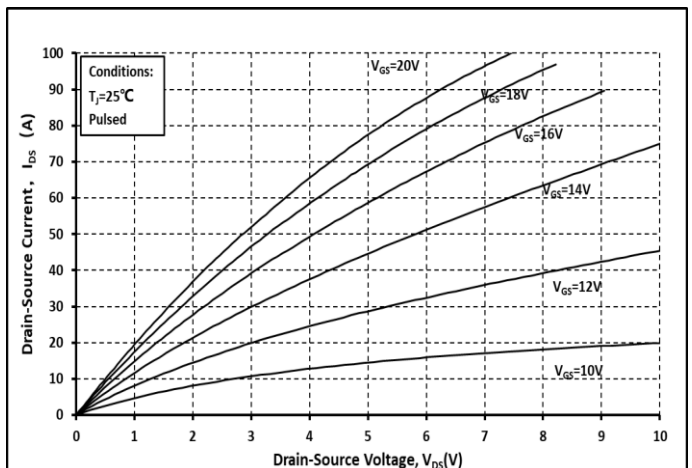


图. 2 输出曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

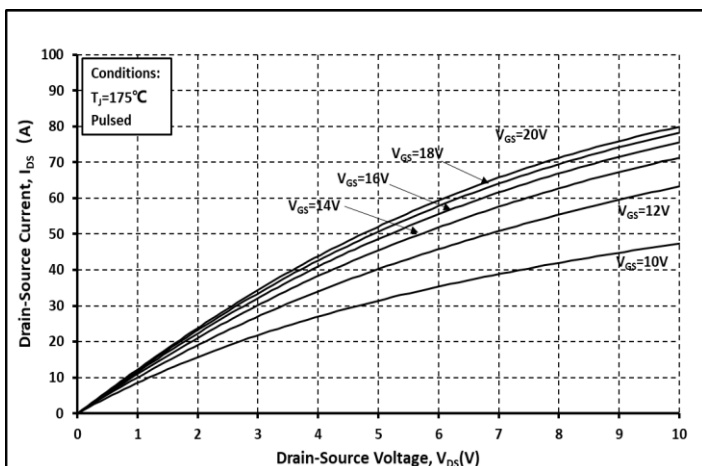


图. 3 输出曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

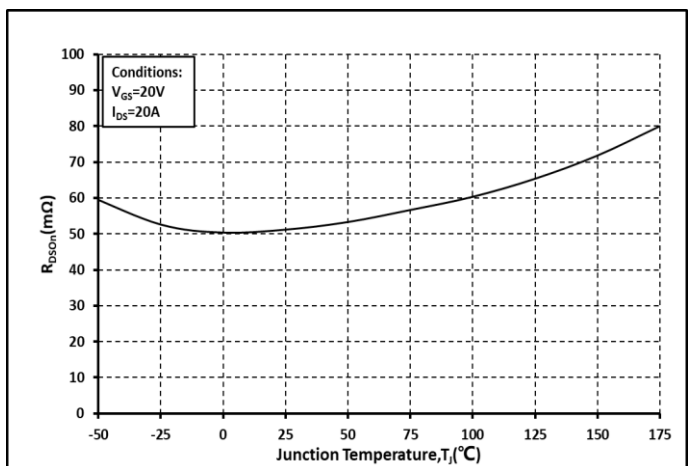


图. 4 R_{on} 和温度关系曲线

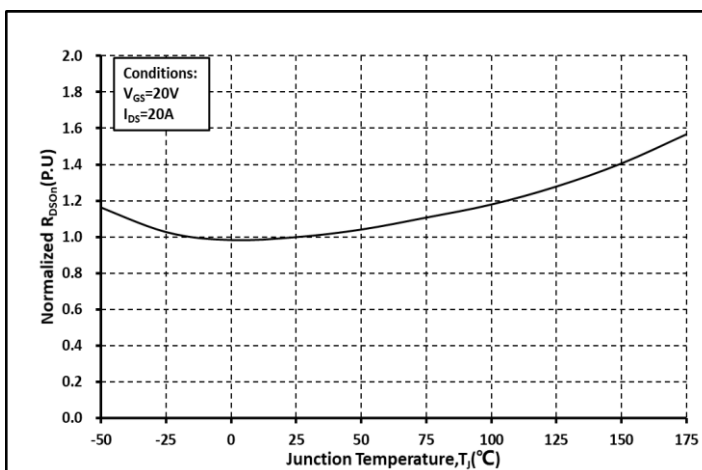


图. 5 归一化的 R_{on} 和温度关系曲线

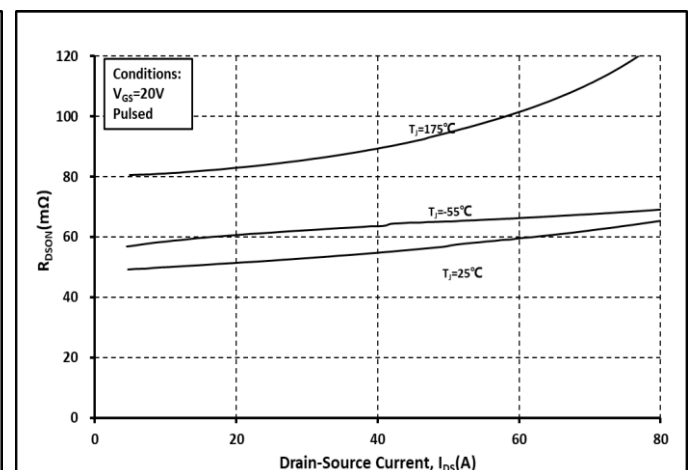


图. 6 各温度下的 R_{on} 和 I_{ds} 关系曲线

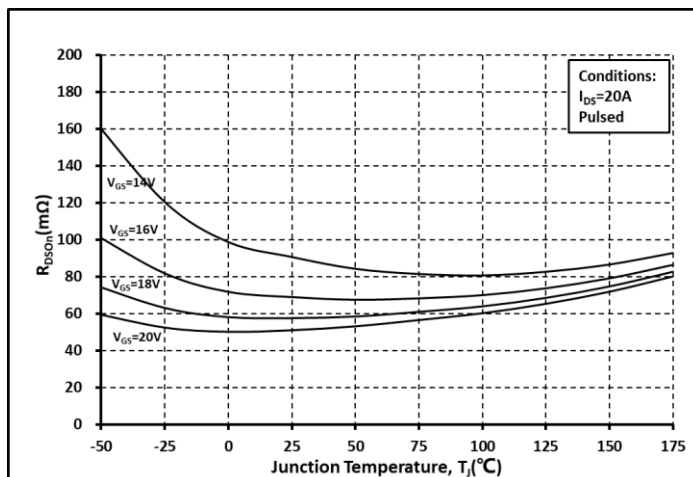


图. 7 各 V_{GS} 下的 R_{on} 和温度关系曲线

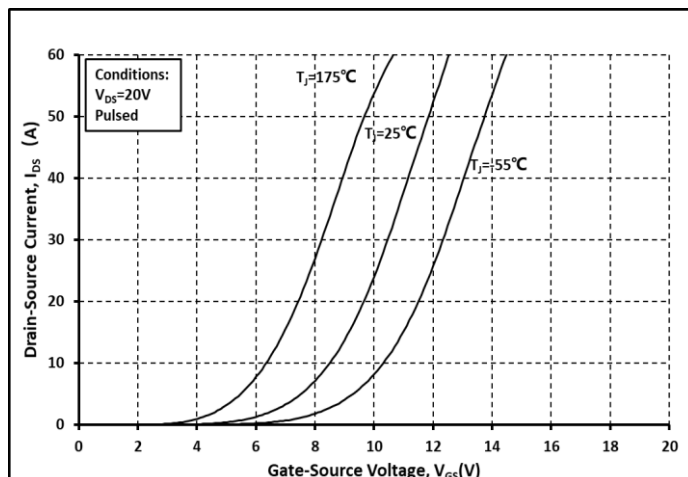


图. 8 各温度下的传输特性曲线

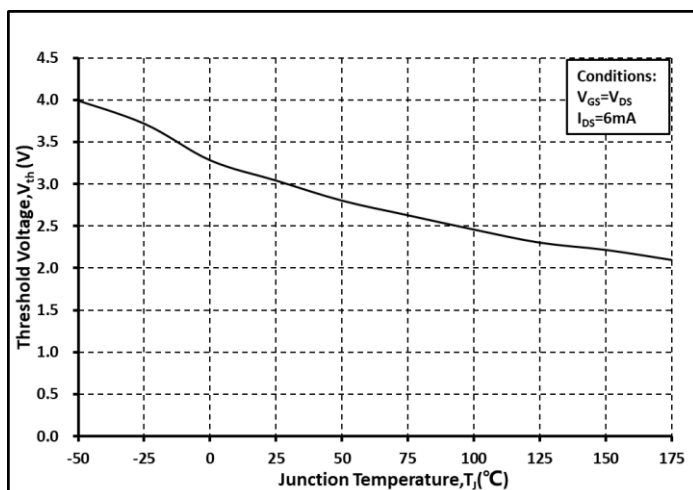


图. 9 阈值电压随温度变化曲线

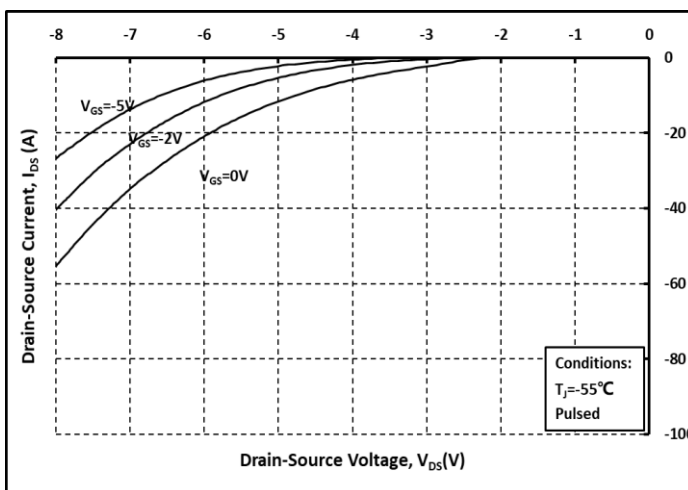


图. 10 体二极管导通曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

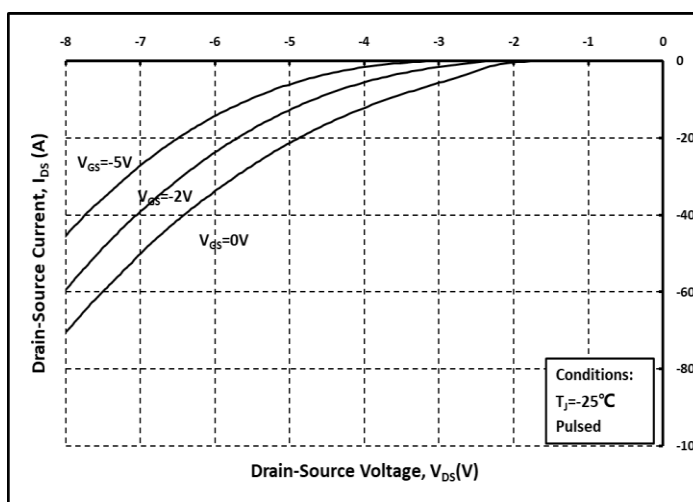


图. 11 体二极管导通曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

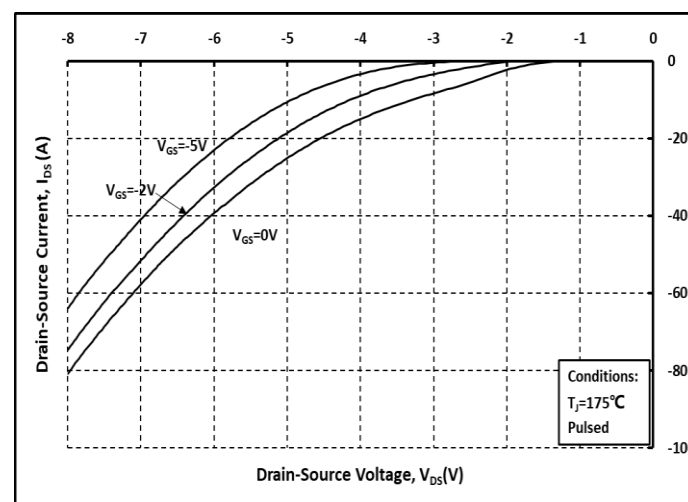


图. 12 体二极管导通曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

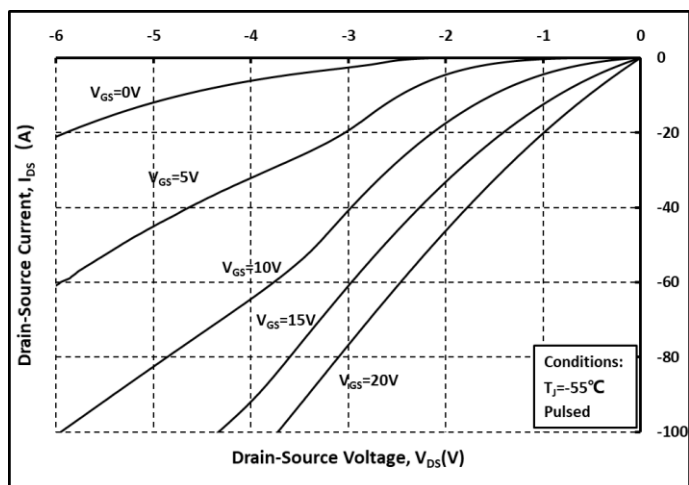


图. 13 第三象限曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

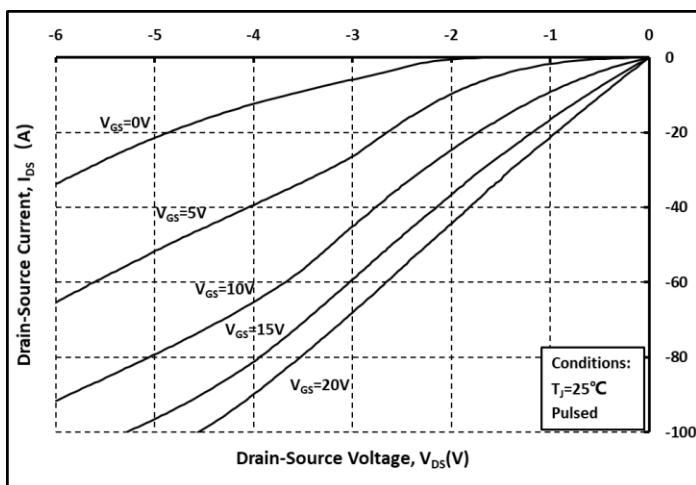


图. 14 第三象限曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

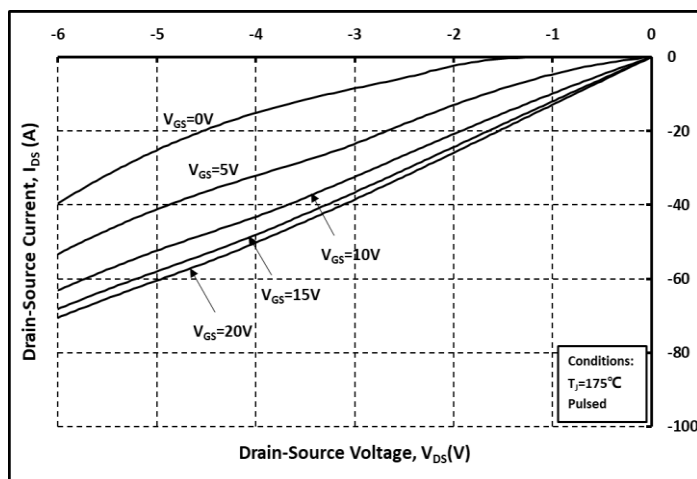


图. 15 第三象限曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

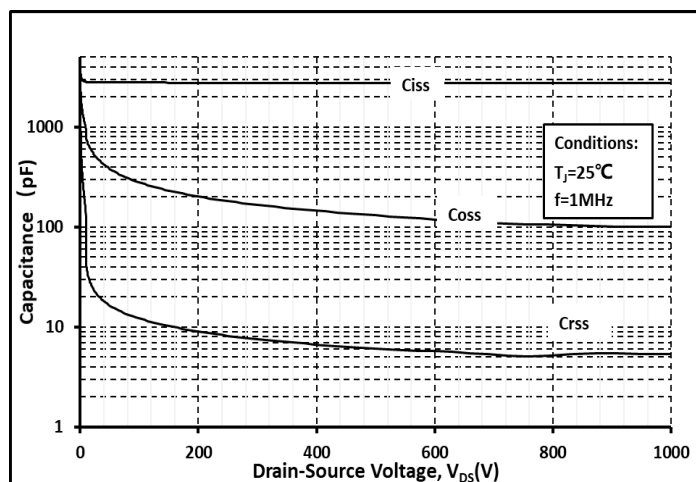


图. 16 各电容和 V_{DS} 关系曲线

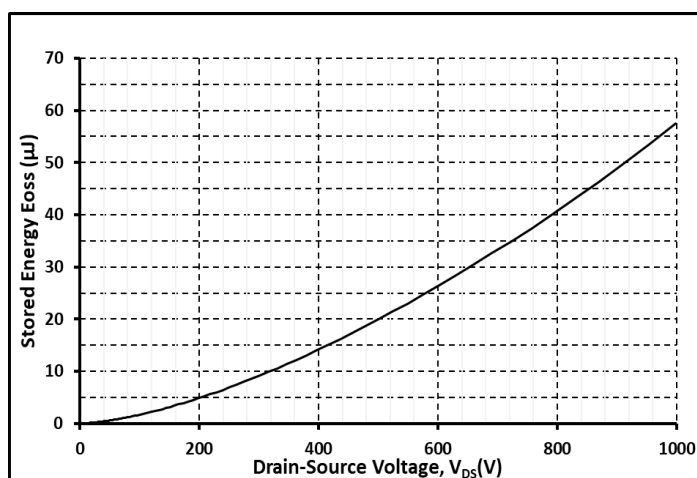


图. 17 输出电容存储能量曲线

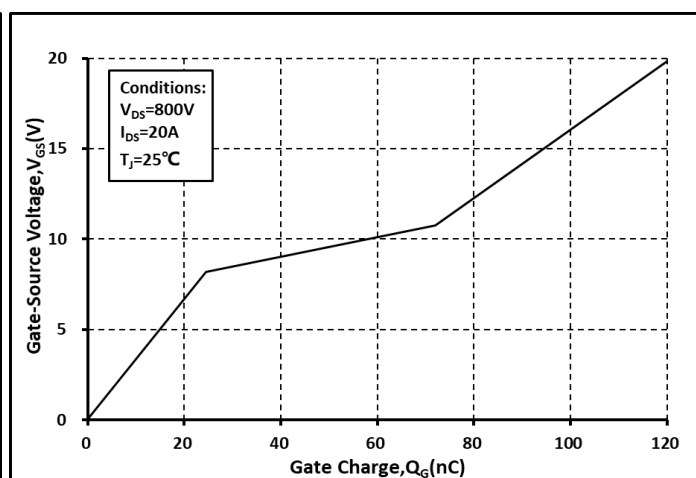


图. 18 栅电荷特征曲线

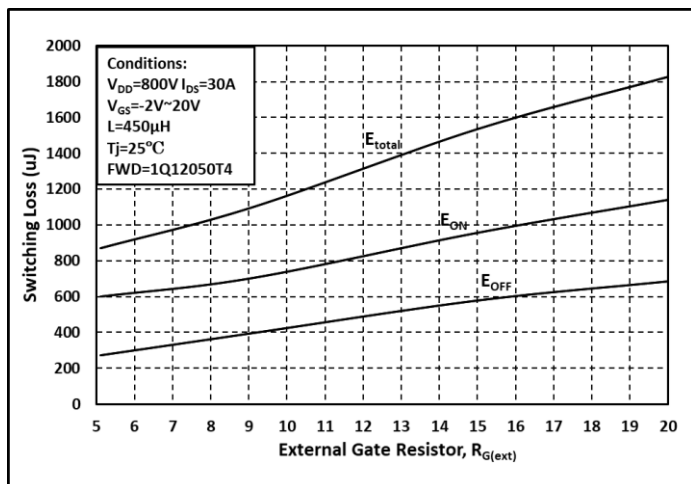


图. 19 开关能量和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

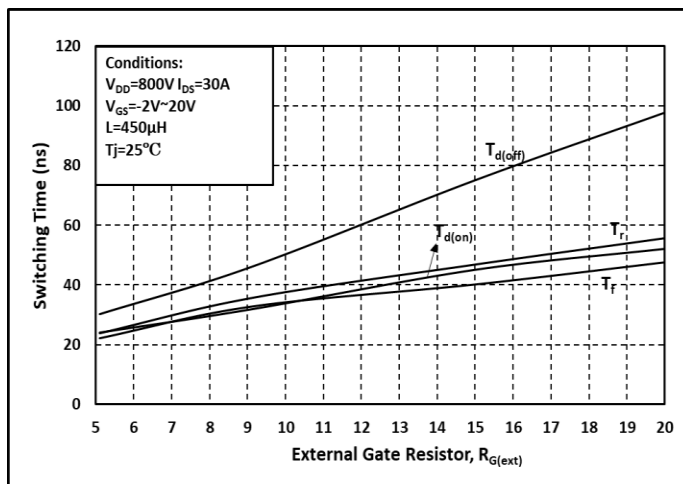


图. 20 开关时间和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

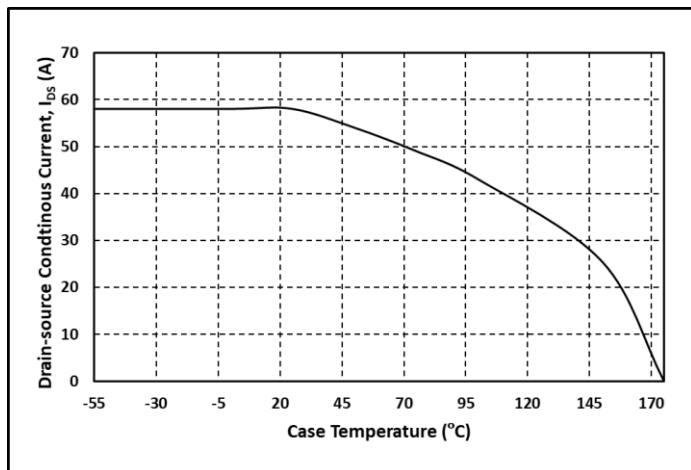


图. 21 漏端电流和温度关系曲线

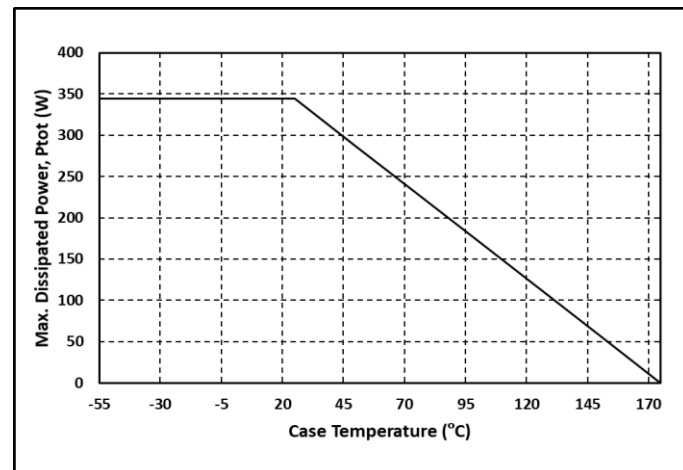


图. 22 最大功耗降额和温度关系曲线

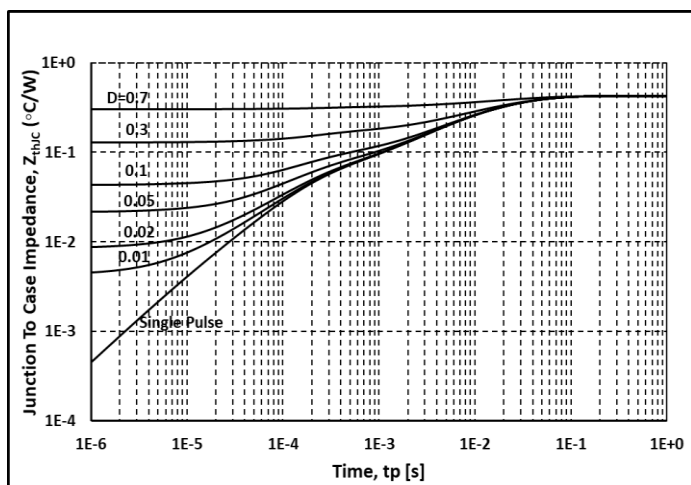


图. 23 热阻曲线

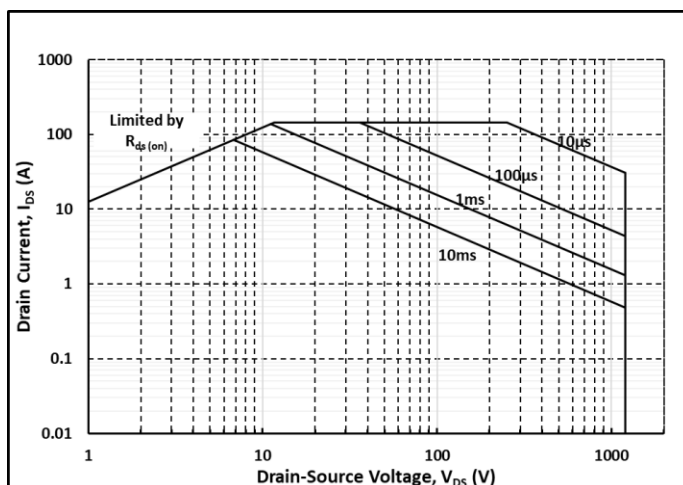
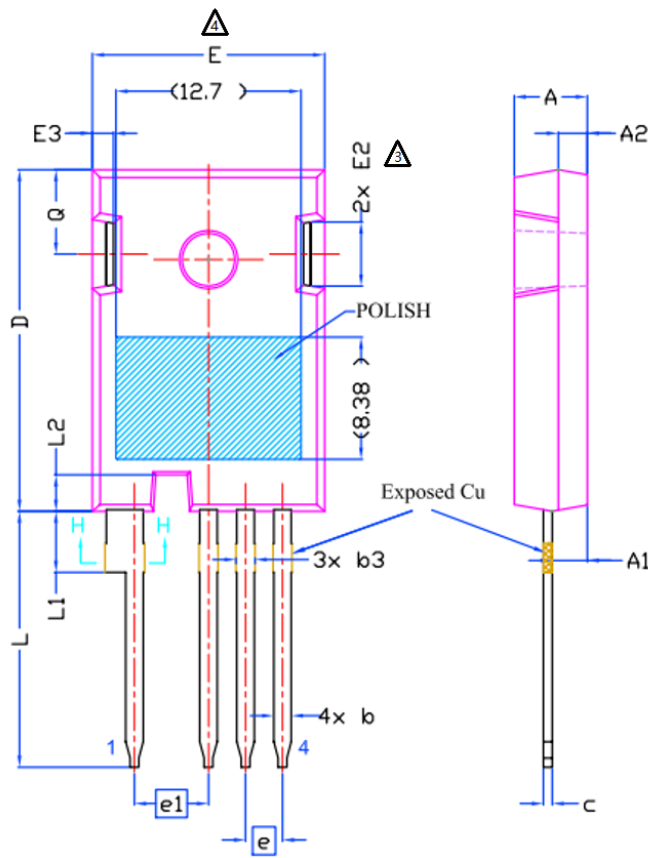
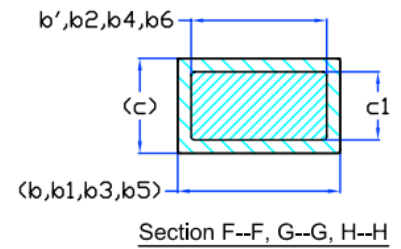
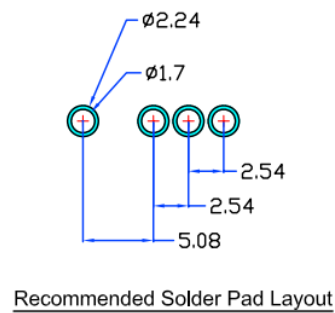
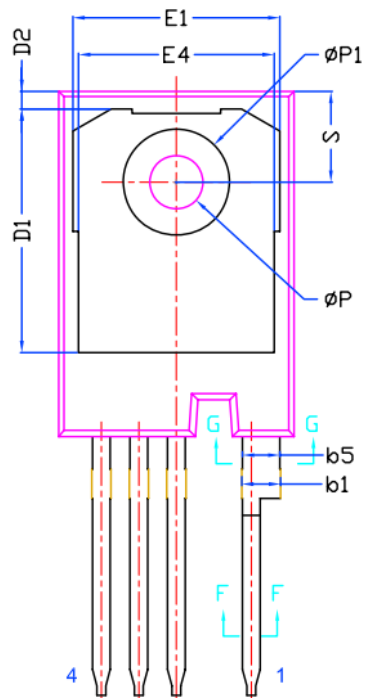


图. 24 安全工作区示意图

封装尺寸



Dimensions In Millimeters		
SYMBOL	MIN.	MAX.
A	4.83	5.21
A1	2.29	2.54
A2	1.91	2.16
b	1.07	1.33
b'	1.07	1.28
b1	2.39	2.94
b2	2.39	2.84
b3	1.07	1.60
b4	1.07	1.50
b5	2.39	2.69
b6	2.39	2.64
c	0.55	0.68
c1	0.55	0.65
D	23.30	23.60
D1	16.25	17.65
D2	0.95	1.25
E	15.75	16.13
E1	13.10	14.15
E2	3.68	5.10
E3	1.00	1.90
E4	12.38	13.43
e	2.54 BSC	
e1	5.08 BSC	
L	17.31	17.82
L1	3.97	4.37
L2	2.35	2.65
N	4	
φP	3.51	3.65
φP1	7.18 REF.	
Q	5.49	6
S	6.04	6.3



说明:

1. 封装标准参考: : JEDEC TO247, Variation AD
2. 以上单位为: 毫米
3. 需要开槽, 槽口可为圆形
4. 尺寸 D 和 E 不包括模具溢料
5. 如有变更, 不另行通知